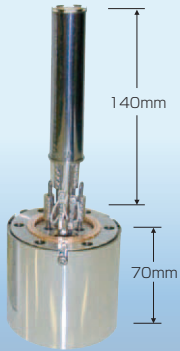


スーパーミニKセル(KC-1300-S)



特徴

分析装置などに最適な超小型Kセルです。

仕様

- 最高加熱温度：1300℃
- ルツボ材質：PBN
- ルツボ容量：2cc
- 取付フランジ：ICF70

デュアルKセル(DSGC-1400SH)



特徴

1つのセルポートで2つの材料を使用できます。

仕様

- 最高加熱温度：1300℃
- ルツボ材質：PBN
- ルツボ容量：6cc
- 取付フランジ：ICF152

Si用高温Kセル(THKC-1000-HI)



特徴

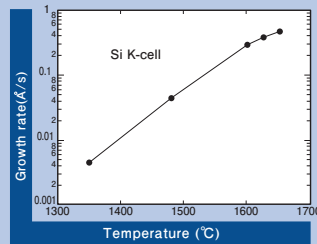
本製品は、世界で初めて、Si用として開発されたKセルであり、EBガンでは、従来コントロールできなかった高精度(0.005~0.5Å/s)の膜厚制御が可能です。

仕様

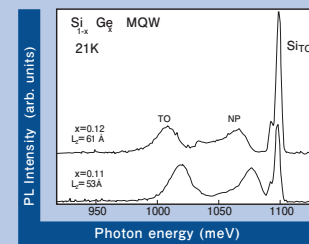
- 最高加熱温度：1600℃
- ルツボ容量：4cc
- 取り付けフランジ：ICF70以上

データ例(Si用高温Kセル) ※東京大学殿ご提供データ

Si用Kセル温度と成長速度の関係



PLスペクトル



ECR ラジカルセル



特徴

本製品は、極めて高密度のプラズマ生成ができる独自構造を採用しています。また先端部に設けられたイオン除去機構(磁場方式)により、イオン除去が可能です。

仕様

- プラズマ生成方式：マイクロ波(2.45GHz)放電型
- イオン除去機構：磁場型
- プラズマ室構成材料：BN
- 電源出力：10W~100W

ECRプラズマセルを用いた分子線エピタキシャル成長(MBE)法により作製したh-GaNおよびc-GaN薄膜の室温でのPLスペクトル、マイクロ波供給電力：60W、窒素流量：1.0sccm。

■大阪大学産業科学研究所殿
ご提供データ

